



¹¹B sous forme de trifluorure de bore gazeux

Description

Le trifluorure de bore gazeux est le dopant idéal pour les plaquettes de silicium destinées à la production de microprocesseurs hautement intégrés et à haute densité. Le ¹¹BF₃ permet d'accroître l'efficacité et le rendement de la production, et contribue à rendre les puces plus petites et plus performantes.

Physical Properties:

Material	11B – Boron-11 in the form of Boron Trifluoride Electronic Grade
Enrichment	11B > 99,9 at%

Chemical Properties

Form	BF ₃
Purity	> 99,9 wt%

Impurities in vppm

Ar+O ₂	5
CO ₂	10
HF	5
N ₂	5
SiF ₄	25
SO ₂	10